

	<h2 style="color: red;">SI4488DY-T1-E3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI4488DY-T1-E3</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 150V 3.5A 8-SOIC</p> <hr/> <p>Datenblätter:  SI4488DY-T1-E3.pdf</p> <hr/> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 10910 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	



Spezifikationen

Teilenummer	SI4488DY-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 150V 3.5A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	10910 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA (Min)
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	50 mOhm @ 5A, 10V
Verlustleistung (max)	1.56W (Ta)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Andere Namen	SI4488DY-T1-E3CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	33 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	36nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	150V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 150V 3.5A (Ta) 1.56W (Ta) Surface Mount 8-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.5A (Ta)

SI4488DY-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4488DY-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4488DY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI4488DY-T1-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI4488DY-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 150V 3.5A 8-SOIC</p>	 <p>SI4490DY SI SI4490DY SI</p>	 <p>SI4487DY-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 30V 11.6A 8-SOIC</p>	 <p>SI4488DY-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 150V 3.5A 8-SOIC</p>
 <p>SI4488DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 150V 3.5A 8-SOIC</p>	 <p>SI4490 VISHAY SI4490 VISHAY</p>	 <p>SI4490DY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 200V 2.85A 8-SOIC</p>	 <p>SI4487DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 11.6A 8-SOIC</p>

SI4488DY-T1-E3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

Electro-Films (EFI) / Vishay	SI4488DY-T1-E3 Datenblatt	SI4488DY-T1-E3-Datenblätter	SI4488DY-T1-E3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI4488DY-T1-E3
SI4488DY-T1-E3 Electronic	SI4488DY-T1-E3-Komponenten	SI4488DY-T1-E3-Verteiler	SI4488DY-T1-E3-Bild	SI4488DY-T1-E3-Teil
SI4488DY-T1-E3 Preis	SI4488DY-T1-E3 Hersteller	SI4488DY-T1-E3 Bild	SI4488DY-T1-E3 Aktie	SI4488DY-T1-E3 Inventar
SI4488DY-T1-E3 Neu	SI4488DY-T1-E3 Original	SI4488DY-T1-E3 garantiert	SI4488DY-T1-E3 RFQ	SI4488DY-T1-E3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited